

ショートプレゼンテーション

11月15日(月) 17:30~19:00

講演時間:2分

P**: 講演番号

†: Young Researcher Poster Award エントリー者

- P01**[†] 高田 陽一 東京大学大学院
水素脱離プロセスが Si 上 Ge エピタキシャル成長層の電気特性に与える効果
- P02**[†] 矢内 章博 東京大学
ポーラス Si による光散乱効果と薄型太陽電池高効率化への応用
- P03** 中村 稔 株式会社 日立製作所 日立研究所
シリコン結晶中 Cu センタ形成に及ぼす Cu 拡散温度の影響
- P04**[†] 竹内 正太郎 コバレントシリコン株式会社
GeSn stressors for Ge CMOS devices
- P05** 船木 透 岡山大学
Si 基板上 B ドープ SiGe 膜中の転位運動
- P06**[†] 原 賢二 東京大学
原子間力顕微鏡による多結晶シリコン太陽電池の結晶粒界近傍における局所的熱解析
- P07** 清水 貴俊 岡山県立大学
Si(100)表面近傍における 3d 遷移金属の拡散に関する第一原理解析
- P08** 荒木 浩司 コバレントシリコン株式会社
Rapid Thermal Processing により導入される熱歪みに対する窒素添加アニールドシリコンウエーハの酸素析出物の効果
- P09**[†] 小松 悟 新潟大学
低温超音波計測によるボロン添加シリコン中の原子空孔観測
- P10** 難波 貴正 岡山県立大学
SiO₂ 結晶中の不純物原子の拡散機構に関する第一原理解析
- P11** 寺井 慶和 大阪大学
Si 基板上に作製した β -FeSi₂ エピタキシャル膜におけるバンド構造評価
- P12**[†] 中川 聡子 コバレントシリコン株式会社

- 電子線照射発光活性化法による低濃度炭素の定量解析
- P13** 南 俊郎 コバレントシリコン株式会社
CZ-Si 単結晶のピンホール欠陥の生成機構
- P14**[†] 馬場 正太郎 新潟大学
ボロン添加シリコンの原子空孔軌道の電気四極子効果
- P15**[†] 小川 貴史 新潟大学
シリコン単原子空孔における電気四極子の第一原理的評価
- P16**[†] 山川 洋一 新潟大学
シリコン原子空孔の電荷状態における動的ヤーン・テラーフォノンの効果
- P17** 市野 将弘 静岡理科大学
光照射下における n 型シリコン中の鉄不純物
- P18**[†] 山田 武見 新潟大学
シリコン原子空孔の電子状態に対するグリーン関数法
- P19** 青木 竜彦 コバレントシリコン株式会社
シリコンウェーハアニールプロセスへのスリップシミュレーションの適用
- P20** 小島 拓人 豊田工業大学
(110)/(100)シリコン接合界面の電気的特性に対する Ni 汚染の影響
- P21** 河本 直哉 山口大学
ポリカーボネート基板上における多結晶シリコン薄膜の低温成長
- P22** 重松 芳紀 岡山県立大学
歪み Si 結晶中における汚染金属の拡散機構に関する第一原理解析
- P23**[†] 立花 福久 明治大学
太陽電池用多結晶 Si 中の小角粒界の電気的活性度における高温熱処理が及ぼす影響
- P24**[†] 岡山 太 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
多結晶シリコン中の小角粒界における深い準位の室温フォトルミネッセンス解析
- P25** 白井 光雲 大阪大学
シリコン格子空孔の動的性質
- P26**[†] 岩井 隆晃 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
ドナー・アクセプタ濃度の高いシリコンのフォトルミネッセンス解析
- P27**[†] 鈴木 都文 東京工業大学

シリコン中の鉄不純物応力誘起拡散の直接観察

P28[†] 岡部 和樹 新潟大学
Practical evaluation of vacancy concentration in silicon crystals and wafers by ultrasonic measurements with organic P(VDF/TrFE) transducers

P29 王 冬 九州大学
SiN 堆積した自立型 Si メンブレンに於ける局所ひずみのマイクロフォトルミネッセンス評価

P30[†] 滝口 亮 筑波大学
Si ナノワイヤへの B ドーピング制御と動径方向 B 濃度分布評価

P31 太子 敏則 信州大学
B₂O₃ で覆われた融液から成長したゲルマニウム結晶中の酸素関連欠陥の評価

P32[†] 武井 宗久 明治大学
ラマン分光法を用いた測定領域の選択による歪解析

P33 楊 海貴 九州大学
酸化濃縮 SiGe-On-Insulator 基板の欠陥評価と制御

P34 Frederic Mercier 産業技術総合研究所
Numerical investigation of the growth rate enhancement in solution growth of SiC from silicon melts.

P35 高田 和明 岡山大学
有限温度での Si 原子空孔間相互作用：タイトバインディング・シミュレーション

P36[†] 仮屋崎 弘昭 岡山県立大学
Si(110)/(100)直接接合基板の界面構造に関する分子シミュレーション

P37 吉越 章隆 日本原子力研究開発機構
リアルタイム放射光光電子分光, LEED および STM による Si(111)-7x7 表面の室温酸化における吸着状態と表面形状の相関に関する研究